

Некролог

ПАМЯТИ ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА УСТИНОВА



25 сентября 2024 г. на 67-м году жизни после тяжелой болезни скончался выдающийся специалист в области физики и технологии полупроводниковых наногетероструктур, член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии РФ, премии Правительства Санкт-Петербурга, заместитель директора ФТИ им. А. Ф. Иоффе по научной работе (2009–2015), директор НТЦ микроэлектроники РАН, заведующий кафедрой оптоэлектроники, член редколлегии журнала "Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника" Виктор Михайлович Устинов.

Виктор Михайлович Устинов родился 01 июля 1958 г. Он был широко известным специалистом в области физики и технологии полупроводниковых наногетероструктур, автором и соавтором более 550 научных работ, в том числе 1 монографии и 6 патентов.

В. М. Устинов работал в ФТИ им. А. Ф. Иоффе с 1981 г. после окончания с отличием базовой кафедры оптоэлектроники ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина) при ФТИ им. А. Ф. Иоффе, которой впоследствии руководил. С 2016 г. возглавлял ФГБУН "Научно-технологический центр

микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук".

В. М. Устиновым были разработаны технология синтеза методом молекулярно-пучковой эпитаксии полупроводниковых гетероструктур с квантовыми точками, созданы инжекционные лазеры на квантовых точках для применений в системах волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), по своим характеристикам превосходящие существующие в настоящее время лазеры на квантовых ямах. Впервые были созданы вертикально-излучающие лазеры (ВИЛ) на квантовых точках. Таким образом, были созданы научно-технологические основы для разработки полупроводниковых инжекционных лазеров нового поколения. За этот цикл работ В. М. Устинову в 2001 г. была присуждена Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники. В 2006 г. В. М. Устинов был избран членом-корреспондентом РАН.

В последние годы научная работа В. М. Устинова была сконцентрирована в области разработки технологии синтеза новых полупроводниковых материалов и светоизлучающих приборов на их основе. Была разработана технология получения полупроводниковых гетероструктур для малошумящих и мощных СВЧ-транзисторов и монолитных интегральных схем в см- и мм-диапазонах, генераторов, детекторов и умножителей частоты в ТГц-диапазоне.

Помимо работы в редколлегии журнала "Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника" В. М. Устинов являлся главным редактором журнала "Письма в ЖТФ".

В. М. Устинов был удостоен ряда международных и российских научных премий. В 2021 г. он получил премию Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации "Нанотехнологии – премия им. Ж. И. Алферова".

Память о Викторе Михайловиче Устинове – замечательном ученом и талантливом организаторе науки – навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив редакции журнала